

Signalsensoren Ø5 mm Metallfassungen

Indicator Sensors Ø5 mm Metal Holders

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 4

General Remarks and Technical Data

General remarks and technical data: see page 4

Spezifische Technische Daten

Gehäusewerkstoff: CuZn verchromt

Steckeinsatz: PC UL94 schwarz

Wellenlänge: λ 950 nm

Strahlstärke: I_e 20 mW/sr bei Durchlassstrom I_f 100 mA

Durchlaßspannung: V_f 1.3 V bei Durchlassstrom I_f 100 mA

Ausstiegszeit t_r , Abfallzeit t_f : 400 ns

Halbwinkel: $\varphi \pm 22^\circ\text{C}$

Specific Technical Data

Housing Material: CuZn chrome plated

Plug Insert: PC UL94 black

Wavelength: λ 950 nm

Radiant Intensity: I_e 20 mW/sr at Forward current I_f 100 mA

Forward Voltage: V_f 1.3 V at Forward current I_f 100 mA

Rise time t_r , Fall time t_f : 400 ns

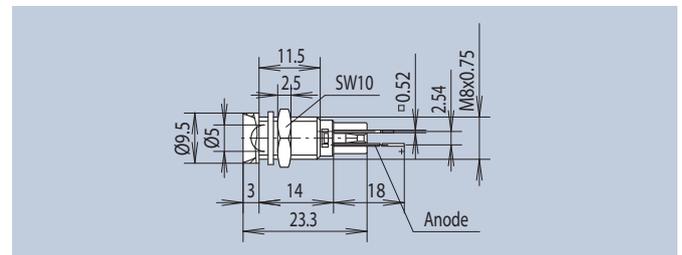
Half angle: $\varphi \pm 22^\circ\text{C}$

Die Infrarot-Dioden zeichnen sich durch gute spektrale Anpassung an Fototransistoren, hohe Strahlstärke und große Reichweite (6-10 m) aus. Sie sind für Impulsbetrieb geeignet. Die Signalsensoren für Frontplatteneinbau sind für Schraubbefestigung mit einer empfohlenen Einbaubohrung von Ø 8 mm ausgelegt.

The infrared diodes are characterised by their good spectral adaptation to photo transistors, high beam intensity and long range distances (6-10 m). They are suitable for pulsed operation. The signal sensors for front panel installation are designed for screw mounting with a recommended installation hole of Ø 8 mm.



Art.-Nr. 2690.8001

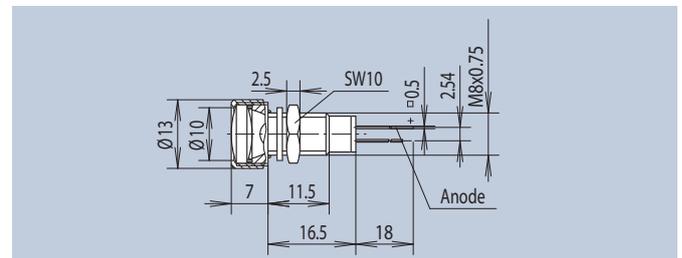


Durch Verwendung von Dichtungen ist die Infrarot-Diode in strahlwassergeschützter Ausführung IP 65 einsetzbar. Lieferung inklusive Scheibe und Mutter.

Seals allow the infrared diode to be used in water jet-proof IP65 designs. Supplied with washer and hexagonal nut.



Art.-Nr. RTM 5070



Spezifische Technische Daten

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung: $V_{BR\ CE0}$ 30V

Emitter-Kollektor-Durchbruchspannung: $V_{BR\ E0C}$ 5V

Verlustleistung: P_{tot} 100mW

Ausstiegszeit t_r , Abfallzeit t_f : 3 μ s

Wellenlänge: λ 940 nm

Kollektor-Emitter-Strom: I_{PCE} 100 μ A

Specific Technical Data

Collector-Emitter-Breakdown Voltage: $V_{BR\ CE0}$ 30V

Emitter-Collector-Breakdown Voltage: $V_{BR\ E0C}$ 5V

Power Dissipation: P_{tot} 100mW

Rise time t_r , Fall time t_f : 3 μ s

Wavelength: λ 940 nm

Kollektor-Emitter-Current: I_{PCE} 100 μ A

Der Fototransistor zeichnet sich durch gute spektrale Anpassung an Infrarot-LED's aus. Er ist geeignet für Bereiche der sichtbaren und nahen infraroten Strahlung. Er besitzt eine hohe Fotoempfindlichkeit. Für Frontplatteneinbau mit Schraubbefestigung und einer empfohlenen Einbaubohrung von Ø 8 mm ausgelegt.

The photo transistor is characterised by its good spectral adaptation to infrared LEDs. It is suitable for visible and near-infrared radiation. It has a high photosensitivity. Designed for front panel installation with screw mounting and a recommended installation hole of Ø 8 mm.



Art.-Nr. 2691.8001

